

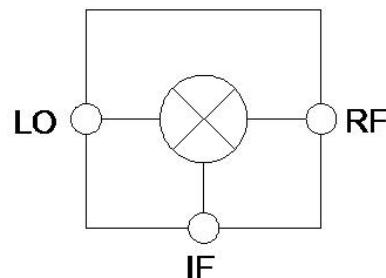
关键指标

- RF/LO 频段：5~16GHz
- IF 频段：DC~6GHz
- 变频损耗：8.5dB
- 本振功率：+13dBm
- 封装尺寸：3mm×3mm×1.2mm

典型应用

- 雷达和电子对抗
- RF/微波电路
- 军事和航天
- 测试测量

功能框图



产品简介

XT3510 是一款 GaAs MMIC 无源双平衡混频器变频封装芯片，这种 MMIC 混频器是在 GaAs 工艺中制造的，不需要外部元件或匹配电路。该装置既可作为上变频器又可用于下变频器

电性能 (T_A=25°C, LO=+13dBm)

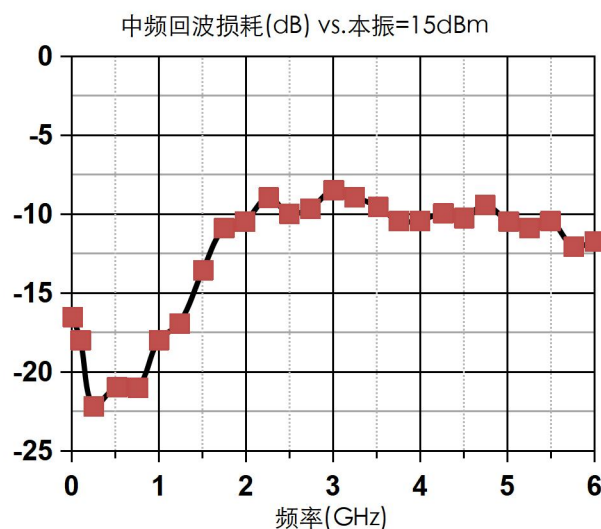
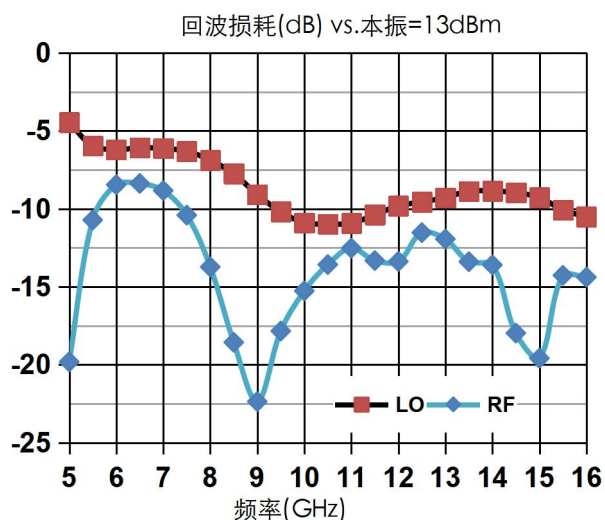
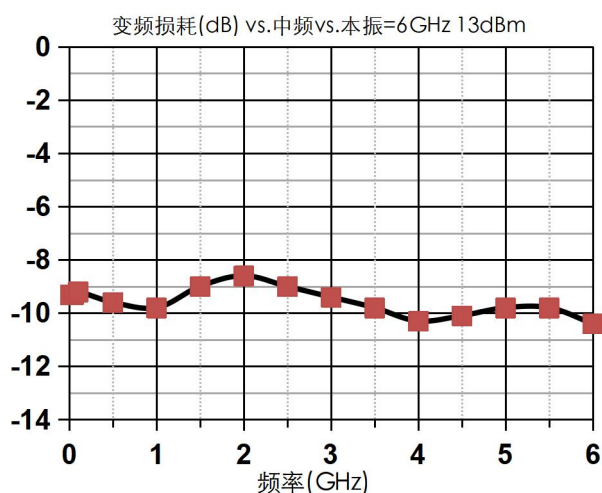
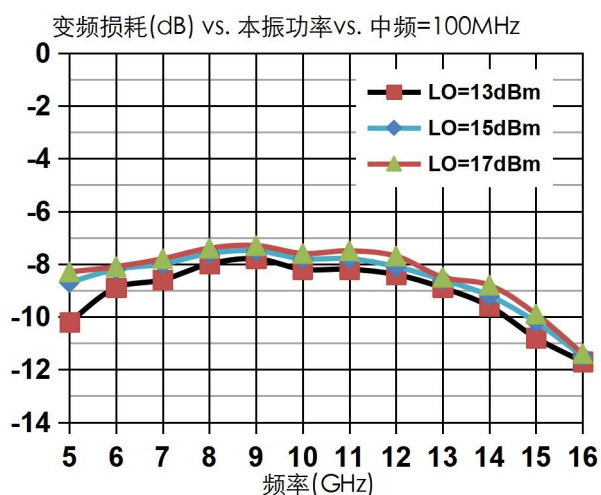
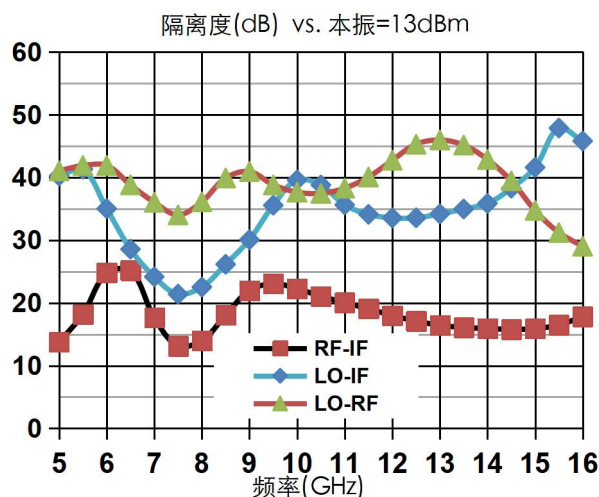
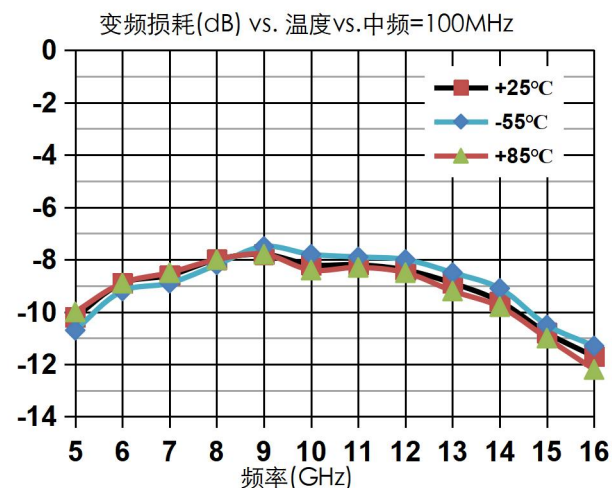
指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频/本振频率	5.0~16.0			GHz
中频频率	DC~6			GHz
变频损耗	—	-8.5	-13	dB
中频回波损耗	-8	-12	—	dB
射频回波损耗	-7	-13	—	dB
本振回波损耗	-4	-7.5	—	dB
本振到射频隔离度	-25	-38	—	dB
本振到中频隔离度	-17	-33	—	dB
射频到中频隔离度	-10	-16	—	dB
输入 1dB 增益压缩	10	12	—	dBm

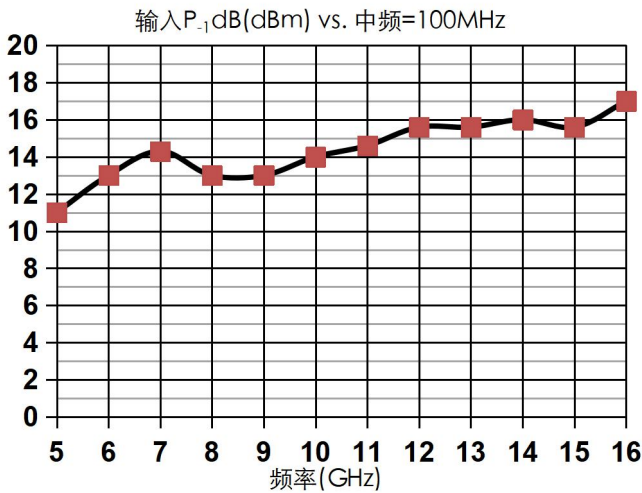
绝对最大额定值

射频/中频最大输入功率	+20dBm	工作温度	-55°C~+85°C
本振最大输入功率	+20dBm	存储温度	-65°C~+150°C

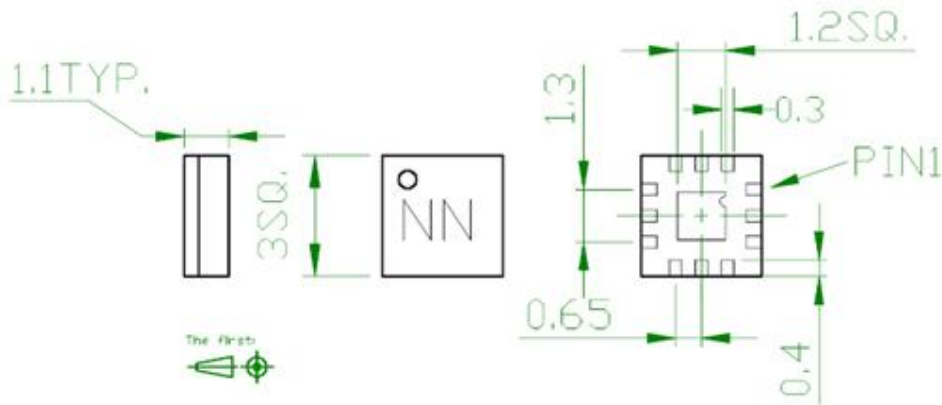


典型测试曲线





外形尺寸 (mm)



引脚功能

编号	说明	编号	说明
1	接地	7	接地
2	本振端口, 未隔直	8	射频端口, 未隔直
3	接地	9	接地
4	接地	10	接地
5	中频端口, 未隔直	11	接地
6	接地	12	接地

注意事项

砷化镓 MMIC 器件易受静电放电损伤。在运输、装配和试验过程中应采取防范措施。